



	<h2 style="color: red;">SI7842DP-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI7842DP-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 6.3A PPAK SO-8
	Datenblätter:  SI7842DP-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 3812 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7842DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 6.3A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3812 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 6.3A 1.4W
Serie	LITTLE FOOT®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.4W
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 7.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Cut Tape (CT)
Basisteilenummer	SI7842
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7842DP-T1-GE3CT

SI7842DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7842DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7842DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7842DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7844DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 6.4A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7844DP VISHAY SI7844DP VISHAY</p>	 <p>SI7842DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 6.3A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7844DP-T1 VISHAY SI7844DP-T1 VISHAY</p>
 <p>SI7844DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 6.4A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7844DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 6.4A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7842DP SI SI7842DP SI</p>	 <p>SI7842DP-T1 VISHAY VISHAY QFN8</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ⚙ SI7810DN-T1-E3 | ↔ SI7810DN-T1-E3 | ⇒ SI7812DN-T1-E3 | D SI7812DN-T1-E3 | ⇒ SI7812DN-T1-GE3 |
| ⊣ SI7812DN-T1-GE3 | ⚙ SI7818DN-T1-E3 | D SI7818DN-T1-E3 | ⇒ SI7820DN-T1-E3 | ⇒ SI7820DN-T1-E3 |
| ⚙ SI7820DN-T1-GE3 | ⊣ SI7820DN-T1-GE3 | ⚙ SI7840BDP | ↔ SI7840BDP-T1-E3 | ⇒ SI7840BDP-T1-E3 |
| D SI7840BDP-T1-GE3 | ⚙ SI7840BDP-T1-GE3 | ⊣ SI7840DP | ⚙ SI7840DP-T1 | ⇒ SI7840DP-T1-E3 |
| ⇒ SI7840DP-T1-GE3 | ↔ SI7840DP-T1-GE3. | ⚙ SI7842DP | ⊣ SI7842DP-T1-E3 | ⇒ SI7842DP-T1-E3 |
| ↔ SI7842DP-T1-GE3 | ⇒ SI7844DP | D SI7844DP-T1 | ⚙ SI7844DP-T1-E3 | ⊣ SI7844DP-T1-E3 |
| ⚙ SI7844DP-T1-GE3 | D SI7844DP-T1-GE3 | ⇒ SI7846DP | ↔ SI7846DP-T1-E3 | ⇒ SI7846DP-T1-E3 |
| ⊣ SI7846DP-T1-GE3 | ⚙ SI7846DP-T1-GE3 | ↔ SI7846DP-T1 | ⇒ SI7846SAC | ⇒ SI7848BDP-T1-E3 |
| ⚙ SI7848BDP-T1-E3 | ⊣ SI7848BDP-T1-GE3 | ⚙ SI7848BDP-T1-GE3 | D SI7848DP | ⇒ SI7848DP-T1-E3 |
| ↔ SI7848DP-T1-E3 | ⚙ SI7848DP-T1-GE3 | ⊣ SI7850DP | ⚙ SI7850DP-T1-E3 | ⇒ SI7850DP-T1-E3 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited